

РАСЧЁТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА ПО ПОПЕРЕЧНОМУ СЕЧЕНИЮ ПРОВОДНИКОВ С ГАРМОНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ

При протекании по проводникам переменного тока из-за поверхностного эффекта и эффекта близости по отдельным частям проводников протекают токи различной плотности. Знание распределения плотности токов используется для расчёта тепловыделения в отдельных частях проводников или для расчёта электромагнитных усилий, действующих как на проводники в целом, так и на отдельные его части.

Допустим, что имеются два одинаковых длинных проводника произвольного сечения (рис. 1) с прямым и обратным токами $i = I_m \sin(\omega t)$. Разобьем поперечное сечение каждого проводника на элементарные площадки, по возможности квадратные. Размеры площадок – ячеек должны быть в несколько раз меньше, чем эквивалентная глубина проникновения поля $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \gamma}}$, где μ, γ – магнитная проницаемость ($\frac{\Gamma_H}{M}$) и удельная объёмная электропроводность материала проводника ($\frac{1}{\Omega \cdot M}$). Во втором проводнике разбиение сечения производится аналогично, так, чтобы каждой элементарной площадке соответствовала такая же площадка первого проводника. При таком разбиении элементарные площадки в проводнике с прямым током и соответствующие им площадки в проводнике с обратным током можно рассматривать как сечения элементарных проводников со своим током I_k , где k – номер площадки.

Допустим, что площадки пронумерованы от 1 до n . В силу симметрии токи I_k в элементарных проводниках с обратным и прямым токами одинаковые. Такие два элементарных проводника можно рассматривать как проводники k -го элементарного контура с током I_k . Таким образом, реальные проводники заменяются системой n элементарных контуров, в каждом из которых протекает свой ток. Если найти токи в каждом элементарном контуре, а затем плотность тока в элементарных проводниках, то задача по определению поля плотности тока во всём проводнике будет решена.

Длина проводников в направлении оси z равна l (рис. 1). Для системы n элементарных контуров можно составить электрическую схему замещения (рис. 2). На схеме обозначены: i – мгновенное значение суммарного тока в проводнике; i_1, i_2, \dots, i_n – мгновенные значения токов в элементарных проводниках; $L_{1,1}, L_{2,2}, \dots, L_{n,n}$ – собственные индуктивности элементарных контуров; R_1, R_2, \dots, R_n – активные сопротивления элементарных контуров.

Для схемы замещения на рис. 2 можно составить следующие уравнения

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\Psi_{1,2}}{dt} + i_1 \cdot R_1(T) - i_2 \cdot R_2(T) = 0; \quad \frac{dT_1}{dt} = \frac{i^2 \cdot R_1(T)}{m \cdot c \cdot (1 + \alpha \cdot T_1)} \\ \dots \quad \dots \\ \frac{d\Psi_{n-1,n}}{dt} + i_{n-1} \cdot R_{n-1}(T) - i_n \cdot R_n(T) = 0; \quad \frac{dT_n}{dt} = \frac{i^2 \cdot R_n(T)}{m \cdot c \cdot (1 + \alpha \cdot T_n)} \\ i = \sum_{k=1}^n i_k \end{array} \right.$$

(*)

где $\Psi_{1,2} = \Psi_1 - \Psi_2; \dots; \Psi_{n-1,n} = \Psi_{n-1} - \Psi_n$, T_1, \dots, T_n – температуры участков.

В предыдущие уравнения входят потокосцепления элементарных контуров Ψ_k , $k=1, \dots, n$, которые определяются следующим образом:

$$\Psi_1 = L_{1,1} \cdot i_1 + L_{1,2} \cdot i_2 + \dots + L_{1,n} \cdot i_n$$

.....

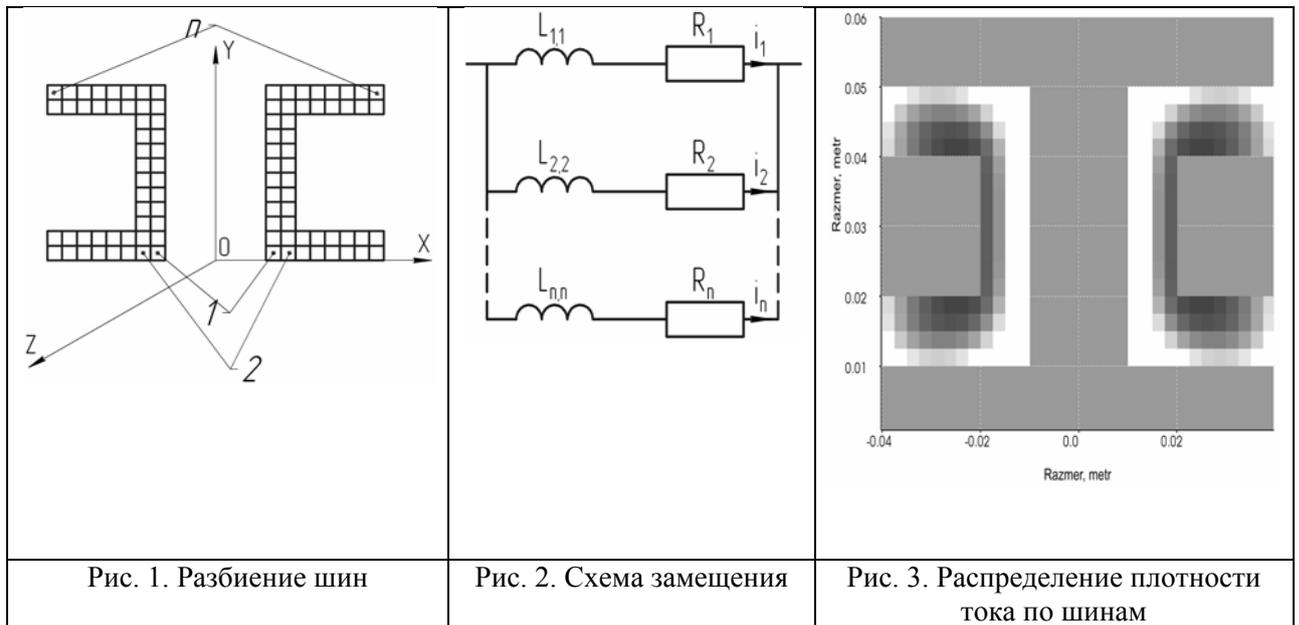
$$\Psi_n = L_{n,1} \cdot i_1 + L_{n,2} \cdot i_2 + \dots + L_{n,n} \cdot i_n$$

где $L_{k,k}$ – собственная индуктивность элементарного контура; $L_{k,m}$ – взаимная индуктивность k-го и m-го контуров [1].

Таким образом, решением системы уравнений (*) определяются токи во всех элементарных участках. Плотность тока σ_k в каждом элементарном проводнике

определяется по формуле $\sigma_k = \frac{I_k}{S_k}$. Картина распределение плотности тока приведена на

рис. 3. По данному алгоритму была написана программа в среде Microsoft Visual Fortran 6.6c.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчёт индуктивностей. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 488 с.